

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

К.т.н. В. М. Чмиль

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

*Д.т.н. Н. М. Вакив (г. Львов)
Д.т.н. В. Н. Годованюк (г. Черновцы)
К.т.н. А. А. Дашковский (г. Киев)
Н. В. Кончиц (г. Киев)
Д.ф.-м.н. В. Ф. Мачулин (г. Киев)
Д.т.н. Г. А. Оборский (г. Одесса)
Е. А. Тихонова (г. Одесса)*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

*Д.т.н. С. Г. Антощук (г. Одесса)
Д.т.н. А. А. Ащеулов (г. Черновцы)
Д.т.н. В. В. Баранов (г. Минск)
К.т.н. Э. Н. Глушеченко,
зам. гл. редактора (г. Киев)
Д.т.н. В. В. Данилов (г. Донецк)
К.т.н. И. Н. Еримичой,
зам. гл. редактора (г. Одесса)
К.т.н. А. А. Ефименко,
ответственный секретарь (г. Одесса)
Д.ф.-м.н. Д. В. Корбутяк (г. Киев)
Д.т.н. С. Ю. Лузин (г. С.-Петербург)
Д.т.н. В. П. Малахов (г. Одесса)
К.т.н. И. Л. Михеева (г. Киев)
Д.т.н. И. Ш. Невлюдов (г. Харьков)
Д.т.н. Ю. Е. Николаенко (г. Киев)
К.ф.-м.н. А. В. Рыбка (г. Харьков)
К.т.н. В. В. Рюхтин (г. Черновцы)
Д.ф.-м.н. М. И. Самойлович (г. Москва)
Д.т.н. В. С. Ситников (г. Одесса)
Д.т.н. Я. Стеванович (г. Белград)
Д.т.н. З. Стевич (г. Белград)
Д.х.н. В. Н. Томашик (г. Киев)
Д.т.н. В. М. Шокало (г. Харьков)
Д.ф.-м.н. О. И. Шпотюк (г. Львов)*

УЧРЕДИТЕЛИ

МПП Украины
Институт физики полупроводников
им. В. Е. Лашкарёва
Научно-производственное
предприятие «Сатурн»
Одесский национальный
политехнический университет
Издательство "Политехперіодика"

Одобрено к печати Ученым советом
ОНПУ

(Протокол № 2 от 23.10.2012 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

Электронные средства: исследования, разработки

Многоуровневые платы с толстопленочной полимерной изоляцией. *Спириг В. Г.* 3

Светодиодные показывающие электронизмерительные устройства на многопороговых компараторах. *Оборский Г. А., Ковальков В. И., Тихенко В. Н., Слободяник П. Т.* 8

Тепловая математическая модель полупроводниковых приборов при измерении ВАХ импульсным способом. *Ермоленко Е. А., Бондаренко А. Ф., Баранов А. Н.* 14

Сенсоэлектроника

Напокристаллы $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ в роли чувствительных элементов сенсора магнитного поля и температуры. *Дружинин А. А., Островский И. П., Ховерко Ю. Н., Ничкало С. И., Корещук Р. Н.* 19

Функциональная микро- и наноэлектроника

Повышение надежности диодов Шоттки при воздействии разрядов статического электричества. *Солодуха В. А., Турцевич А. С., Соловьёв Я. А., Рубцевич И. И., Керенцев А. Ф.* 22

Фотоэлектрические свойства гетеропереходов $n\text{-SiC}/n\text{-Si}$. *Семенов А. В., Козловский А. А., Пузиков В. М.* 27

Фотодиод на основе GaP с повышенной чувствительностью в коротковолновой области УФ-спектра. *Добровольский Ю. Г.* 31

Влияние распределения примеси в базе на фотоэлектрические свойства поверхностно-барьерных УФ-фотоприемников. *Бобренко Ю. Н., Комащенко В. Н., Ярошенко Н. В., Шереметова Г. И., Атаев Б. С.* 35

Технологические процессы и оборудование

Технология создания легированных бором слоев на алмазе. *Зяблюк К. Н., Митягин А. Ю., Талипов Н. Х., Чучева Г. В., Духновский М. П., Хмельницкий Р. А.* 39

Исследование качества пайки кристаллов мощных транзисторов релаксационным импеданс-спектрометром. *Турцевич А. С., Рубцевич И. И., Соловьёв Я. А., Васьков О. С., Кононенко В. К., Нисс В. С., Керенцев А. Ф.* 44

Массоперенос при жидкофазной эпитаксии двухслойных систем. *Дранчук С. Н., Завадский В. А., Мокрицкий В. А.* 48

Список рецензентов номера 52